	<p>FDB0165N807L</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDB0165N807L</p>
	<p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 310A TO263</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  FDB0165N807L.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 288 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen









Teilenummer	FDB0165N807L
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 310A TO263
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	288 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.6 mOhm @ 36A, 10V
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 300W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D ² Pak (6 Leads + Tab)
Andere Namen	FDB0165N807LCT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	23660pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	304nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 310A (Tc) 3.8W (Ta), 300W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	310A (Tc)

FDB0165N807L Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB0165N807L-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB0165N807L AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB0165N807L E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>FDB0170N607L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 300A D2PAK</p>	 <p>FDB0105N407L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 460A</p>	 <p>FDB-S Hirose CONN PRESSURE BLOOK FOR SKT</p>	 <p>FDB0170N607L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 300A D2PAK</p>
 <p>FDB0165N807L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 310A TO263</p>	 <p>FDB016N04AL7 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 160A D2PAK-7</p>	 <p>FDB0105N407L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 460A</p>	 <p>FDB-P Hirose CONN PRESSURE BLOOK FOR PLUG</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB0165N807L AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB0165N807L Datenblatt	FDB0165N807L-Datenblätter	FDB0165N807L PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB0165N807L
FDB0165N807L Electronic	FDB0165N807L-Komponenten	FDB0165N807L-Verteiler	FDB0165N807L-Bild	FDB0165N807L-Teil
FDB0165N807L Preis	FDB0165N807L Hersteller	FDB0165N807L Bild	FDB0165N807L Aktie	FDB0165N807L Inventar
FDB0165N807L Neu	FDB0165N807L Original	FDB0165N807L garantiert	FDB0165N807L RFQ	FDB0165N807L Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited